06.3;07;12

Особенности спектров фотолюминесценции монокристаллических пленок Cr⁴⁺ : Ca₂GeO₄

© О.Н. Горшков, Е.М. Дианов, Н.Б. Звонков, А.П. Касаткин, В.Ф. Лебедев, Г.А. Максимов, А.Б. Чигинева, Ю.И. Чигиринский

Научно-исследовательский физико-технический институт Нижегородского государственного университета, Н. Новгород Научный центр волоконной оптики при ИОФ РАН, Москва E-mail: lab10@phys.unn.runnet.ru

Поступило в Редакцию 23 января 2001 г.

Обнаружено, что спектры фотолюминесценции монокристаллических пленок Cr^{4+} : Ca_2GeO_4 , выращенных методом магнетронного распыления на подложках из объемных монокристаллов Ca_2GeO_4 , измеренные при комнатной температуре, содержат резкую линию в области длин волн $\sim 1.17\,\mu\text{m}$, сопровождаемую спутниками при ~ 1.21 и $1.27\,\mu\text{m}$. Особенности спектров пленок обсуждаются в рамках модели, рассматривающей взаимодействие электронов центра Cr^{4+} с возбуждаемыми в пленке колебаниями.

Оптические материалы, легированные хромом, находящимся в состоянии Cr⁴⁺, представляют интерес в связи с возможностью генерации лазерного излучения в диапазоне длин волн 1.2–1.5 μ m, перспективном для волоконно-оптических систем связи. Особый интерес для создания элементов интегральной оптики представляет формирование таких материалов в пленочном варианте. Недавно в работе [1] были предста-

1

влены данные по получению рентгеноаморфных пленок Cr^{4+} : Ca_2GeO_4 , полученных методом ВЧ-магнетронного распыления на подложках из плавленого кварца, и показано, что спектр фотолюминесценции пленок, измеренный при комнатной температуре, содержит широкую полосу в области длин волн $\sim 1.3 \,\mu$ m, которая практически совпадает с полосой фотолюминесценции объемных монокристаллов Cr^{4+} : Ca_2GeO_4 при той же температуре [2].

В настоящей работе обсуждаются особенности спектров фотолюминесценции монокристаллических пленок Cr^{4+} : Ca_2GeO_4 , осажденных на монокристаллические подложки германата кальция (Ca_2GeO_4) с ориентацией (110). Условия и режимы формирования пленок были такими же, как и в случае создания пленок на подложках из плавленого кварца (см. [1]). Структура полученных пленок анализировалась рентгенодифракционными методами на установке "Дрон-3" в геометрии "скользящего пучка". Анализ показал, что полученные пленки были монокристаллическими. Несоответствие параметров кристаллических решеток подложки и пленки определялось из анализа кривой качания, и было показано, что его величина составляет $5 \cdot 10^{-4}$ nm.

Возбуждение фотолюминесценции осуществлялось с помощью диодного лазера на длине волны $\lambda = 980$ nm излучением мощностью 1 W. Обнаружено, что спектры фотолюминесценции пленок, полученные при комнатной температуре (см. рисунок, кривая *I*), содержат резкую линию в области длин волн $\lambda_1 \sim 1.17 \,\mu$ m, сопровождаемую спутниками при $\lambda_2 \sim 1.21$ и $\lambda_3 \sim 1.27 \,\mu$ m. Спектры такого вида возникают также в объемных монокристаллах с оливиновой структурой Cr⁴⁺: Ca₂GeO₄ при температуре жидкого азота (см. рисунок, кривые *3*, *4*) и Cr⁴⁺: Mg₂SiO₄ (форстерит) при температуре 10K [3] и соответствуют электронному переходу из состояния ³A₁Cr⁴⁺-центра в кристаллическом поле искаженного тетраэдра в основное состояние ³A₂ [3]. Следует отметить, что для объемных монокристаллов Cr⁴⁺: Ca₂GeO₄ спектры, измеренные при комнатной температуре (кривая на вставке, см. рисунок; см. также соответствующий спектр в [2]), имеют вид широкой полосы с максимумом при $\lambda_3 \sim 1.25 \,\mu$ m.

Спектры пленок (СП) проявляют также следующую специфику: 1) частота колебаний, определенная из СП по усредненному положению первого и второго спутников ($\nu \sim 337 \, {\rm cm}^{-1}$), превосходит таковую для объемных монокристаллов Cr⁴⁺: Ca₂GeO₄ ($\nu \sim 132 \, {\rm cm}^{-1}$) и Cr⁴⁺: Mg₂SiO₄ ($\nu \sim 153 \, {\rm cm}^{-1}$) [3]; 2) СП имеют дополнительный пик,



1*

Спектры фотолюминесценции пленок Cr^{4+} : Ca₂GeO₄, осажденных на поверхности (110) монокристалла Ca₂GeO₄, измеренные при комнатной температуре (*I*) и при температуре жидкого азота (*2*); спектр фотолюминесценции объемных монокристаллов Cr^{4+} : Ca₂GeO₄, измеренный при температуре жидкого азота (*3*); *4* — то же из работы [2]. На вставке — спектр фотолюминесценции объемного кристалла Cr^{4+} : Ca₂GeO₄, измеренный при комнатной температуре.

расположенный на коротковолновом плече резкой линии; 3) наиболее интенсивная линия в СП сдвинута относительно таковой в спектрах объемных монокристаллов (СОМ) в коротковолновую область примерно на 30 nm; 4) в СП слабо представлены спутники с энергией $\nu \sim 700 \, {\rm cm}^{-1}$, которые проявляют себя в СОМ [3,4]; 5) изменение температуры от 77 до 300 К приводит к уширению резкой линии без существенного сдвига ее максимума и изменения ее формы (см. рисунок, кривые *1*, *2*).

Спектры объемных монокристаллов Cr⁴⁺ : Ca₂GeO₄ и Cr⁴⁺ : Mg₂SiO₄ интерпретируются [2–4] в рамках модели, описывающей взаимодействие электронов Cr⁴⁺-центра с локальными колебаниями этого центра и оптическими модами колебаний кристаллической решетки [5-7]. Это взаимодействие определяется фактором Хуана–Риса (S), характеризующим превращение части энергии, выделяемой при переходе электрона, в энергию локальных колебаний или колебаний решетки. Этот параметр может быть определен, зная из эксперимента отношение площадей первого колебательного спутника и узкой линии (так называемой бесфононной линии (БФЛ)). В этой модели условие перехода от спектра с тонкой структурой, содержащего БФЛ и колебательные спутники, к спектру в виде широкой полосы характеризуется параметром $a = (S/2) \operatorname{cth}(\nu/2kT)$, где ν — энергия возбуждаемых центром колебаний, которая определяется положением спутников, *k* — постоянная Больцмана, Т — абсолютная температура. При рассматриваемом переходе параметр *a* меняется от значений $a \ll 1$ к значениям $a \gg 1$.

В нашем случае фактор Хуана-Риса для $\nu \sim 337 \text{ cm}^{-1}$ равен S = 0.2и при комнатной температуре a = 0.3, что соответствует условию формирования тонкой структуры спектра (отметим, что появлению такой структуры способствует достаточно высокое значение ν). По данным работы [3] для объемных монокристаллов $\operatorname{Cr}^{4+}: \operatorname{Mg}_2\operatorname{SiO}_4$ при 10 K фактор S = 0.7. Полагая, что этот параметр слабо зависит от температуры, для комнатной температуры при $\nu = 153 \text{ cm}^{-1}$ получим a = 2.2. Для объемных монокристаллов $\operatorname{Cr}^{4+}: \operatorname{Ca}_2\operatorname{GeO}_4$ оценка *S* из СОМ, измеренных при температуре жидкого азота, дает S = 0.4. Делая аналогичные предположения для *S* и ν (132 cm⁻¹) при комнатной температуре получим a = 1.4. Таким образом, при комнатной температуре фактор *a* для монокристаллических пленок существенно меньше приведенных значений *a* для объемных монокристаллов $\operatorname{Cr}^{4+}: \operatorname{Mg}_2\operatorname{SiO}_4$ и $\operatorname{Cr}^{4+}: \operatorname{Ca}_2\operatorname{GeO}_4$.

ческой решетки объемного монокристалла Ca₂GeO₄ в [4] связывают величину ~ 200 cm⁻¹. В нашем случае формирование пленок Cr⁴⁺: Ca₂GeO₄ происходит при температурах 450–500°C, значительно более низких по сравнению с температурой синтеза объемных монокристаллов (например, температура плавления в методе Чохральского для оливиновой фазы Ca₂GeO₄ находится в пределах 1410–1490°C [8]). Поэтому следует ожидать наличия значительного содержания дефектов в кристаллической структуре таких пленок, что в свою очередь может привести к модификации фононного спектра пленок в сторону увеличения частот оптических мод. Решение вопроса о том, может ли эта модификация привести к возникновению в фононном спектре пленок моды с $\nu \sim 337$ cm⁻¹ или экспериментально наблюдаемые нами колебания с этой энергией следует отнести к колебаниям центра Cr⁴⁺, требует проведения дополнительных исследований.

С наличием дефектов может быть связан и наблюдаемый сдвиг БФЛ в СП относительно БФЛ в СОМ в коротковолновую область. Оптические характеристики иона Cr⁴⁺ определяются тетраэдрической симметрией ближайшего (кислородного) кристаллического окружения, силой тетраэдрического кристаллического поля, а также искажением тетраэдрической симметрии. Наличие дефектов в пленках может проявить себя в отмеченном выше увеличении параметра кристаллической решетки пленки и привести к увеличению силы кристаллического поля, соответствующего тетраэдрическому окружению и уменьшению искажения тетраэдра. Оба последних обстоятельства могут привести к наблюдаемому увеличению энергии рассматриваемого электронного перехода.

По-видимому, приведенная выше интерпретация особенностей спектров люминесценции монокристаллических пленок Cr^{4+} : Ca₂GeO₄ не является единственно возможной. Альтернативное объяснение этих особенностей могло бы быть основано на представлении о наличии в пленках других кристаллических фаз [8], которые и обеспечивают возникновение отмеченных особенностей спектра пленок. Вместе с тем следует отметить, что рентгенодифракционный анализ полученных в настоящей работе монокристаллических пленок зафиксировал содержание только оливиновой фазы.

Таким образом, впервые экспериментально показано, что в монокристаллических пленках Cr^{4+} : Ca_2GeO_4 возникает ситуация слабого обмена энергией электронов центра Cr^{4+} с возбуждаемыми в пленке колебаниями при температурах порядка комнатной, что в свою очередь приводит к возникновению тонкой структуры оптического спектра.

Авторы выражают благодарность Т.Т. Басиеву за обсуждение результатов работы, В. Петрисевичу, который также указал на возможность альтернативного объяснения особенностей СП на основе представления о наличии в пленках некоторых новых фаз, В.Н. Трушину за проведение рентгенодифракционных измерений и В.В. Дозмарову за предоставление пластин объемных монокристаллов Ca₂GeO₄ и Cr⁴⁺ : Ca₂GeO₄.

Список литературы

- [1] Горшков О.Н., Дианов Е.М., Звонков Н.Б. и др. // Квант. электроника. 2000. Т. 30. № 3. С. 261–262.
- [2] Petricevic V., Bykov A.B., Evans J.M. et al. // Optics Letters. 1996. V. 21. N 1. P. 1750–1752.
- [3] Jia W., Liu H., Jaffe S. et al. // Phys. Rev. B. 1991. V. 43. N 7. P. 5234-5242.
- [4] Hazenkamp M.F., Gudel H.U., Atanasov M. et al. / Phys. Rev. B. 1996. V. 53. N 5. P. 2367–2377.
- [5] Пекар С.И. // ЖЭТФ. 1950. Т. 20. № 6. С. 510-522.
- [6] Huang K., Phys A. // Proc. Roy. Soc. A. 1950. V. 204. N 1076. P. 406-423.
- [7] Перлин Ю.Е., Цукерблат Б.С. Эффекты электронно-колебательного взаимодействия в оптических спектрах примесных парамагнитных ионов. Кишинев: Штиинца, 1974. 368 с.
- [8] Ширвинская А.К., Гребенщиков Р.Г., Торопов Н.А. // Неорг. материалы. 1966. Т. 2. № 2. С. 332–335.